

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

---

# SH7211 グループ

## BSC SDRAM インタフェース設定例

---

### 要旨

この資料は SH7211 のバスステートコントローラ (BSC) の SDRAM インタフェース機能と、SDRAM との接続例を示します。

### 動作確認デバイス

SH7211

### 目次

1. はじめに.....	2
2. 応用例の説明.....	3
3. 参考プログラム例.....	8
4. 参考ドキュメント.....	11

## 1. はじめに

### 1.1 仕様

- 16M バイト (8M ワード×16 ビット) の SDRAM を使用し、16 ビットバス幅で接続します。
- SH7211 の SDRAM インタフェース機能を使用し、SDRAM の初期化を行います。

### 1.2 使用機能

- バスステートコントローラ (BSC)

### 1.3 適用条件

- マイコン : SH7211
- 動作周波数 : 内部クロック 160MHz  
バスクロック 40MHz  
周辺クロック 40MHz  
MTU2S クロック 80MHz  
AD クロック 40MHz
- C コンパイラ : ルネサス テクノロジ製  
SuperH RISC engine ファミリ C/C++ コンパイラパッケージ Ver.9.01 Release01
- コンパイルオプション : HEW でのデフォルト設定 (-cpu=sh2a -debug -gbr=auto -chgincpath -global\_volatile=0 -opt\_range=all -infinite\_loop=0 -struct\_alloc=1 -nologo)

### 1.4 関連アプリケーションノート

- 本資料の参考プログラムは、SH7211 初期設定アプリケーションノートの設定条件にて動作確認をしています。そちらも合わせてご参照ください。

### 2. 応用例の説明

#### 2.1 使用機能の動作概要

SH7211 のバスステートコントローラ (BSC) を使用し、外部に接続された SDRAM の制御を行います。表 1 に本応用例で使用する SDRAM 仕様を示します。また、図 1 にメモリマップを示します。

表 1 本応用例で使用する SDRAM 仕様

項目	SDRAM 仕様
型名	EDS1216AATA-75E
バスサイズ	16 ビット
容量	2M バイト (16 ビット×1M ワード) ×1 個
パッケージ	48 ピン TSOP (20×12mm)

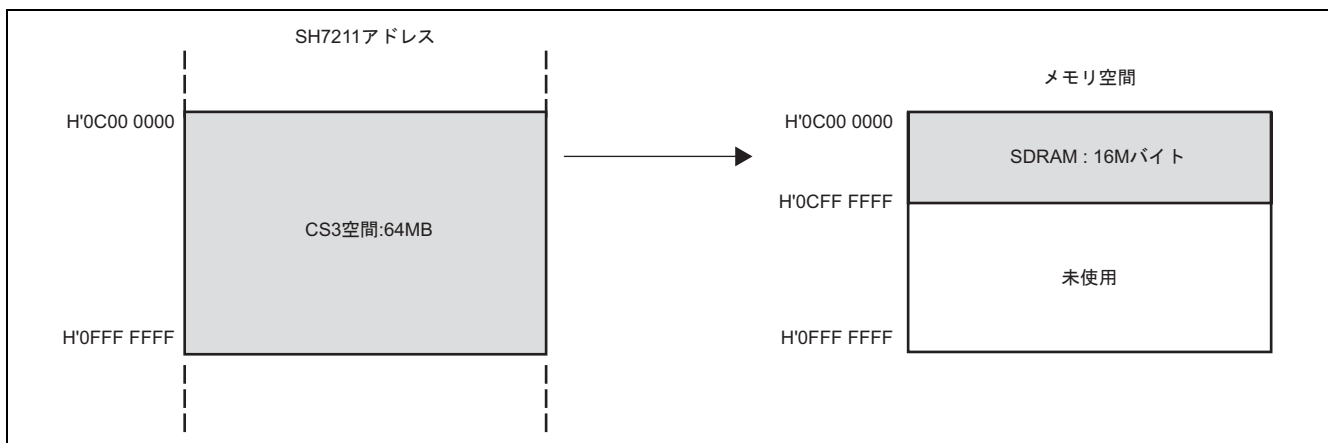


図 1 SDRAM 関連のメモリマップ

図 2 に SDRAM 回路接続例を示します。また、表 2 に SH7211 の端子機能を示します。すべての端子は初期端子機能が I/O ポートとなっていますので、ピンファンクションコントローラ (PFC) による、端子機能の切り替えが必要です。

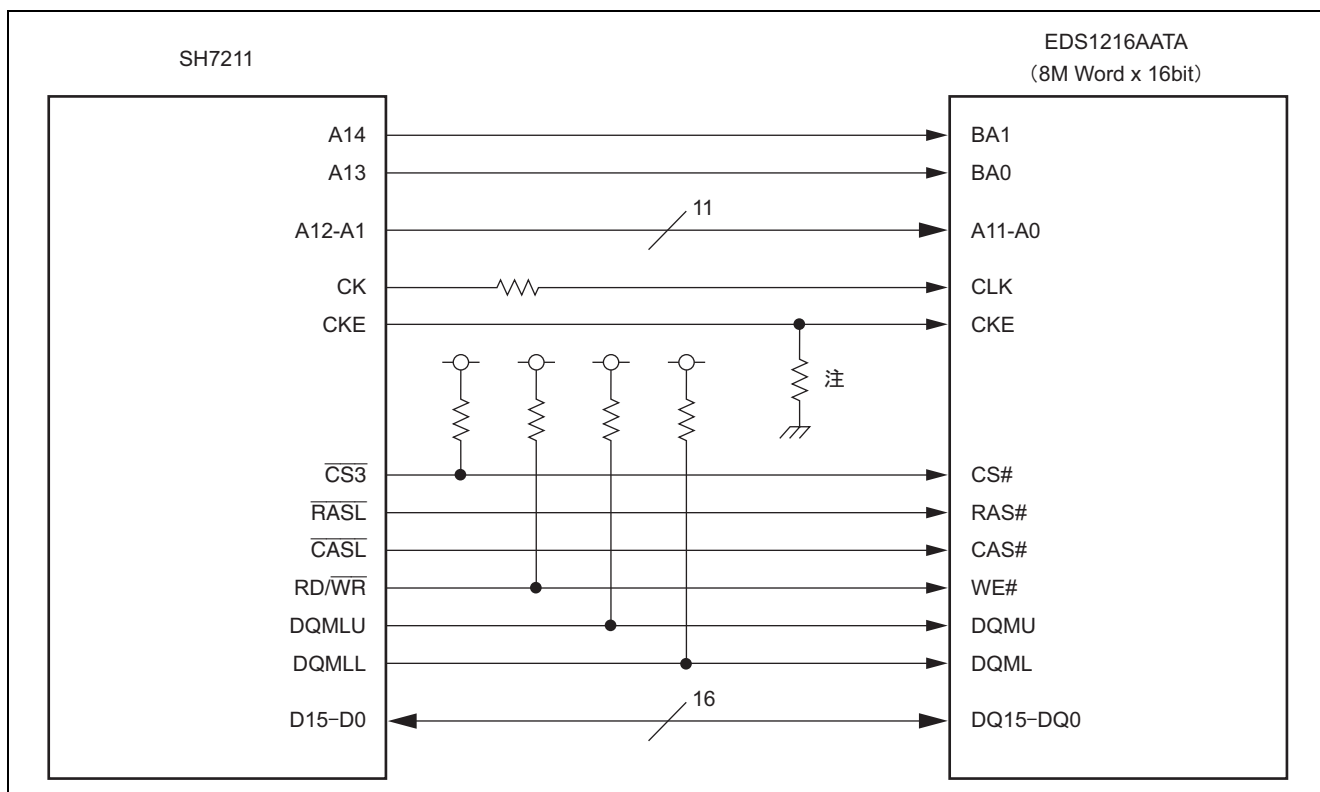


図 2 SDRAM 接続回路例

表 2 SH7211 端子機能

SH7211 端子	入出力	初期端子機能	機能
A14~A1	出力	PA14~PA1	アドレスバス
D15~D0	入出力	PD15~PD0	データバス
CK	出力	PB3	クロック出力
CKE	出力	PB4	クロックイネーブル*
CS3	出力	PB17	チップセレクト
RASL	出力	PB5	RAS 信号
CASL	出力	PB6	CAS 信号
RD/WR	出力	PB1	リードまたはライト信号
DQMLU	出力	PB9	D15~D8 対応のバイト書き込み指示
DQMLL	出力	PB8	D7~D0 対応のバイト書き込み指示

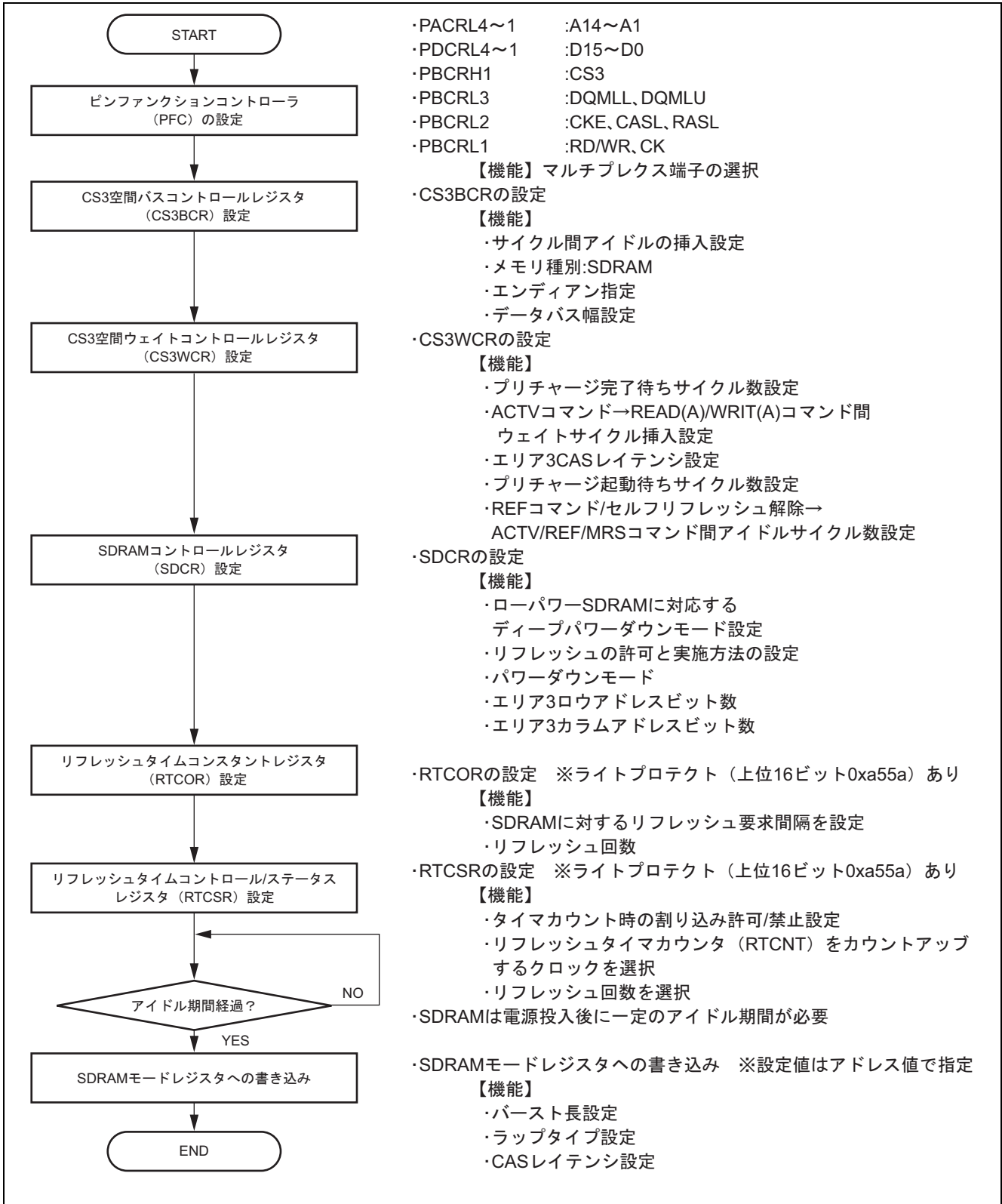
【注】 \* CKE 端子のための端子処理は SDRAM により異なります。  
ご使用になる SDRAM に合わせて Pull up または Pull down を行ってください。

## 2.2 使用機能の設定手順

表3 にバスステートコントローラの設定例を示します。各レジスタの詳細については、「SH7211 グループ ハードウェアマニュアル 第8章 バスステートコントローラ」をご参照ください。図3 にバスステートコントローラの設定手順例を示します。

表3 バスステートコントローラの設定例

レジスタ名	アドレス	設定値	機能
CS3 空間バスコントロールレジスタ (CS3BCR)	H'FFFC 0010	H'1000 4400	<ul style="list-style-type: none"> <li>IWW[2:0]="B'001" ライト-リード/ライト-ライト間アイドル : 1 アイドルサイクル挿入</li> <li>TYPE[2:0]="B'100" : SDRAM</li> <li>BSZ[1:0]="B'10" : 16 ビットバス幅</li> </ul>
CS3 空間ウェイトコントロールレジスタ (CS3WCR)	H'FFFC 0034	H'0000 0091	<ul style="list-style-type: none"> <li>WTRP[1:0]="B'00" プリチャージ完了待ちサイクル数 : ウェイトサイクルなし</li> <li>WTRCD[1:0]="B'00" ACTV コマンド→READ/WRITE コマンド間ウェイトサイクル数 : ウェイトサイクルなし</li> <li>A3CL[1:0]="B'01" エリア 3CAS レイテンシ : 2 サイクル</li> <li>TRWL[1:0]="B'10" WRITE(A)コマンド→オートプリチャージ/PRE コマンドサイクル数 : 2 サイクル</li> <li>WTRC[1:0]="B'01" REF コマンド/セルフリフレッシュ解除→ACTV コマンドサイクル数 : 3 サイクル</li> </ul>
SDRAM コントロールレジスタ (SDCR)	H'FFFC 004C	H'0000 0809	<ul style="list-style-type: none"> <li>RFSH="1" リフレッシュ制御 : リフレッシュする</li> <li>RMODE="0" リフレッシュ制御 : オートリフレッシュを行う</li> <li>BACTV="0" バンクアクティブモード : オートプリチャージモード</li> <li>A3ROW[1:0]="B'01" エリア 3 ロウアドレスビット数 : 12 ビット</li> <li>A3COL[1:0]="B'01" エリア 3 カラムアドレスビット数 : 9 ビット</li> </ul>
リフレッシュタイムコントロール/ステータスレジスタ (RTCSR)	H'FFFC 0050	H'A55A 0010	<ul style="list-style-type: none"> <li>CKS[2:0]="B'010" クロックセレクト : Bφ/16</li> <li>RRC[2:0]="B'000" リフレッシュ回数 : 1 回</li> </ul>
リフレッシュタイムコンスタントレジスタ (RTCOR)	H'FFFC 0058	H'A55A 0027	※クロックセレクトを Bφ/16 に設定した場合のリフレッシュ要求間隔は以下のとおりです。 1 サイクル : 400nsec(40MHz/16=2.5MHz) 本 SDRAM のリフレッシュ要求間隔 : 15.625μsec/回 (64ms ごとの 4096 リフレッシュサイクル) 15.625μsec/400nsec=39 サイクル/リフレッシュ回数



- ・PACRL4~1 :A14~A1
- ・PDCRL4~1 :D15~D0
- ・PBCRH1 :CS3
- ・PBCRL3 :DQMLL, DQMLU
- ・PBCRL2 :CKE, CASL, RASL
- ・PBCRL1 :RD/WR, CK
- 【機能】マルチプレクス端子の選択
- ・CS3BCRの設定
- 【機能】
  - ・サイクル間アイドルの挿入設定
  - ・メモリ種別:SDRAM
  - ・エンディアン指定
  - ・データバス幅設定
- ・CS3WCRの設定
- 【機能】
  - ・プリチャージ完了待ちサイクル数設定
  - ・ACTVコマンド→READ(A)/WRIT(A)コマンド間ウェイトサイクル挿入設定
  - ・エリア3CASレイテンシ設定
  - ・プリチャージ起動待ちサイクル数設定
  - ・REFコマンド/セルフリフレッシュ解除→ACTV/REF/MRSコマンド間アイドルサイクル数設定
- ・SDCRの設定
- 【機能】
  - ・ローパワーSDRAMに対応するディープパワーダウンモード設定
  - ・リフレッシュの許可と実施方法の設定
  - ・パワーダウンモード
  - ・エリア3ロウアドレスビット数
  - ・エリア3カラムアドレスビット数
- ・RTCORの設定 ※ライトプロテクト (上位16ビット0xa55a) あり
- 【機能】
  - ・SDRAMに対するリフレッシュ要求間隔を設定
  - ・リフレッシュ回数
- ・RTCSRの設定 ※ライトプロテクト (上位16ビット0xa55a) あり
- 【機能】
  - ・タイマカウント時の割り込み許可/禁止設定
  - ・リフレッシュタイマカウンタ (RTCNT) をカウントアップするクロックを選択
  - ・リフレッシュ回数を選択
- ・SDRAMは電源投入後に一定のアイドル期間が必要
- ・SDRAMモードレジスタへの書き込み ※設定値はアドレス値で指定
- 【機能】
  - ・バースト長設定
  - ・ラップタイプ設定
  - ・CASレイテンシ設定

図3 バスステートコントローラの設定手順例 (CS3 空間)



図 4 にバスクロック 40MHz 時の SDRAM シングルリード/ライトタイミング例を示します。

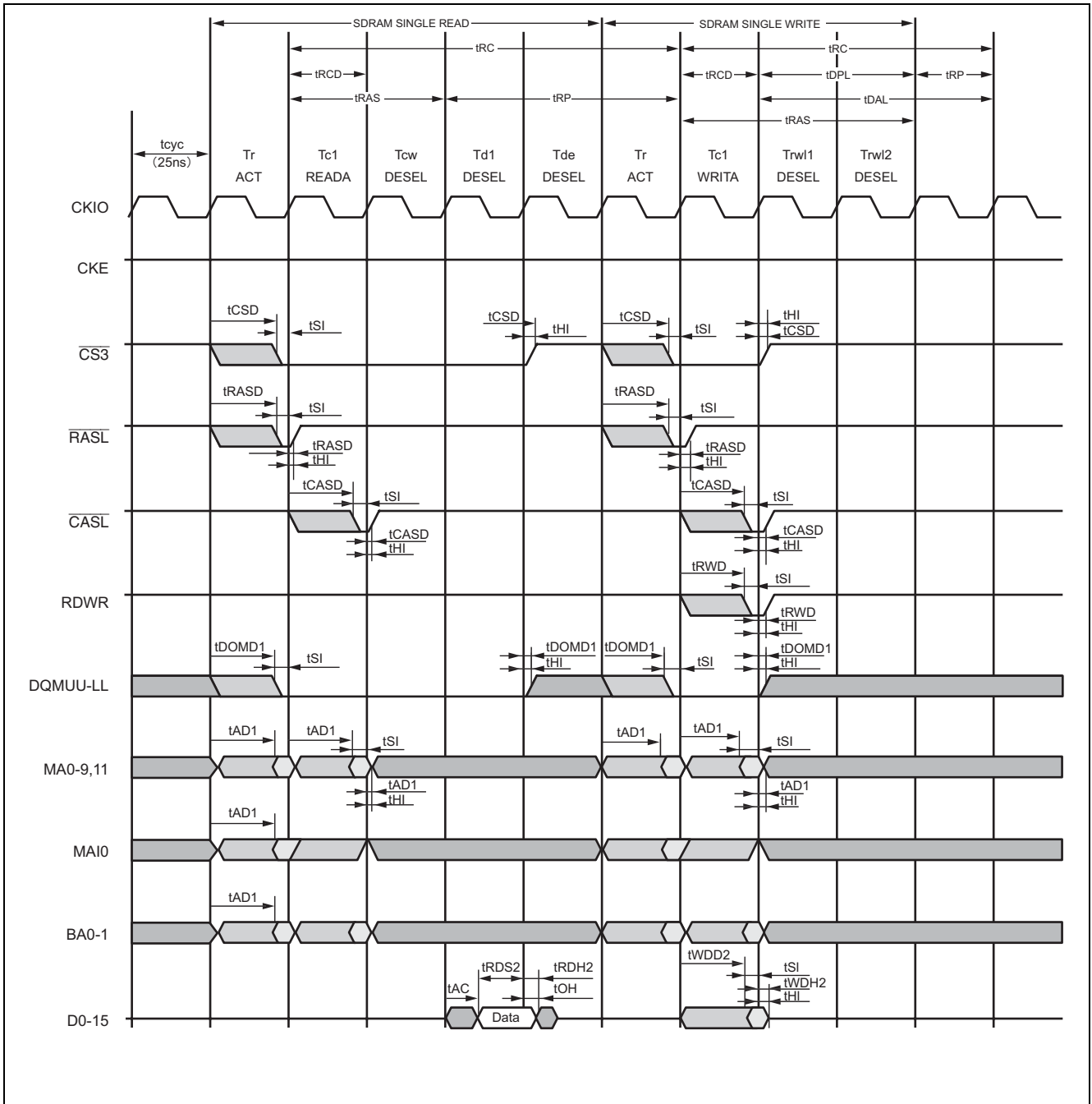


図 4 SDRAM シングルリード/ライトタイミング例

### 3. 参考プログラム例

```

1  /*"FILE COMMENT"*****
2  *
3  *      System Name : SH7211 Sample Program
4  *      File Name   : bsc_sdram.c
5  *      Version     : 1.00.02
6  *      Contents    : SH7211 SDRAM Initial Setting
7  *      Model       : M3A-HS11
8  *      CPU         : SH7211
9  *      Compiler    : SHC9.1.1.0
10 *      OS          : none
11 *
12 *      note        : <注意事項>
13 *                  本サンプルプログラムはすべて参考資料であり、
14 *                  その動作を保証するものではありません。
15 *                  本サンプルプログラムはお客様のソフトウェア開発時の
16 *                  技術参考資料としてご利用ください。
17 *
18 *                  <Caution>
19 *                  This sample programs are all reference,
20 *                  and no one to guarantee the operation.
21 *                  Please use this sample program for the technical
22 *                  reference when customers develop softwares.
23 *
24 *      Copyright (C) 2008 Renesas Technology Corp. All Rights Reserved
25 *      AND Renesas Solutions Corp. All Rights Reserved
26 *
27 *      history     : 2005.04.21 ver.1.00.00
28 *                  : 2005.06.01 ver.1.00.01
29 *                  : 2008.04.04 ver.1.00.02
30 /*"FILE COMMENT END"*****/
31 #include "iodefine.h"
32
33 /* ==== Macro name definition ==== */
34
35 /* The address when writing in a SDRAM mode register */
36 #define SDRAM_MODE      (*(volatile unsigned short *) (0xfffc5440))
37
38 /* ==== Prototype declaration ==== */
39 void io_init_sdram(void);
40

```

図5 サンプルプログラムリスト"bsc\_sram.c" (1)

```

41 /*"FUNC COMMENT"*****
42 * ID      :
43 * Module outline : SDRAM 16 ビットバス幅接続設定
44 *-----
45 * Include  : #include "iodefine.h"
46 *-----
47 * Declaration : void io_init_sdram(void)
48 *-----
49 * Function   : CS3 空間の SDRAM へのアクセスを有効にするために、
50 *           : ピンファンクションコントローラ (PFC) およびバスステート
51 *           : コントローラ (BSC) の設定を行います。
52 *-----
53 * Parameters : None
54 *-----
55 * Return Values : None
56 *-----
57 * Precaution : PFC の設定は他の処理で設定した PFC を変更しないように
58 *           : ビット操作により設定しています。
59 *"FUNC COMMENT END"*****
60 void io_init_sdram(void)
61 {
62     volatile int j = 32000;          /* 200usec wait count @160MHz */
63
64     /* ==== PFC settings ==== */
65     PFC.PACRL4.BIT.PA14MD = 0x1;    /* Set A14 */
66     PFC.PACRL4.BIT.PA13MD = 0x1;    /* Set A13 */
67     PFC.PACRL4.BIT.PA12MD = 0x1;    /* Set A12 */
68     PFC.PACRL3.WORD = 0x1111;      /* Set A11-A8 */
69     PFC.PACRL2.WORD = 0x1111;      /* Set A7-A4 */
70     PFC.PACRL1.BIT.PA3MD = 0x1;    /* Set A3 */
71     PFC.PACRL1.BIT.PA2MD = 0x1;    /* Set A2 */
72     PFC.PACRL1.BIT.PA1MD = 0x1;    /* Set A1 */
73
74     PFC.PDCRL4.WORD = 0x1111;      /* Set D15-D12 */
75     PFC.PDCRL3.WORD = 0x1111;      /* Set D11-D8 */
76     PFC.PDCRL2.WORD = 0x1111;      /* Set D7-D4 */
77     PFC.PDCRL1.WORD = 0x1111;      /* Set D3-D0 */
78
79     PFC.PBCRL1.BIT.PB1MD = 0x1;    /* Set RDWR */
80     PFC.PBCRL1.BIT.PB3MD = 0x1;    /* Set CK */
81     PFC.PBCRL2.BIT.PB4MD = 0x1;    /* Set CKE */
82     PFC.PBCRL2.BIT.PB5MD = 0x1;    /* Set RASL */
83     PFC.PBCRL2.BIT.PB6MD = 0x1;    /* Set CASL */
84     PFC.PBCRL3.BIT.PB8MD = 0x1;    /* Set DQMLL */
85     PFC.PBCRL3.BIT.PB9MD = 0x1;    /* Set DQMLU */
86     PFC.PBCRH1.BIT.PB17MD = 0x1;   /* Set CS3# */
87

```

図 6 サンプルプログラムリスト" bsc\_sram.c" (2)

```

88      /* ==== CS3BCR Setting ==== */
89      BSC.CS3BCR.LONG = 0x10004400ul;
90
91      /* Idle cycles between Raed-Write/Write-Write
92       :1 Idle cycle */
92      /* Memory type :SDRAM */
93      /* Data bus size :16-bit size */
94
95      /* ==== CS3WCR setting ==== */
96      BSC.CS3WCR = 0x00000091ul;
97      /* Precharge completion wait cycles:0cycle */
98      /* Wait cycles between ACTV command and READ/WRIT command :0cycle */
99      /* CAS latency for area3 :2cycles */
100     /* Auto-precharge startup wait cycles:2cycles */
101     /* Idle cycles from REF command/self-refresh relese to ACTV/REF/MRS command :3cycles */
102
103     /* ==== SDCR setting ==== */
104     BSC.SDCR.LONG = 0x00000809ul; /*
105
106     Refresh Control :Refresh
107     RMODE :Auto-refresh is performed
108     BACTV :Auto-precharge mode
109     Row address for Area3 :12-bits
110     Column Address for Area3 :9-bits
111
112     */
111     /* ==== RTCOR setting ==== */
112     BSC.RTCOR = 0xa55a0027ul; /*
113
114     15. 625usec /400nsec = 39 (0x27) cycles/refresh
115
116     */
115     /* ==== RTCSR setting ==== */
116     BSC.RTCSR.LONG = 0xa55a0010ul; /*
117
118     Initialize sequence start
119     Clock select B-clock/16 = 400nsec
120     Refresh count :Once
121
122     */
121     /* ==== 200usec interval elapsed ? ==== */
122     while(j-- > 0) {
123         /* wait */
124     }
125
126     /* ==== Written in SDRAM Mode Register ==== */
127     SDRAM_MODE = 0; /*
128
129     CS3 area/16bit bus size
130     Burst read/Single write
131
132     */
131 }
132 /* End of File */

```

図7 サンプルプログラムリスト" bsc\_sram.c" (3)

#### 4. 参考ドキュメント

- ソフトウェアマニュアル  
SH-2A、SH2A-FPU ソフトウェアマニュアル Rev.3.00  
(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください)。
- ハードウェアマニュアル  
SH7211 グループハードウェアマニュアル Rev.2.00  
(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください)。

#### ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジホームページ  
<http://japan.renesas.com/>

#### 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2009.02.17	—	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したのですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に対する責任を負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
  - 1) 生命維持装置。
  - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
  - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行うもの。
  - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断りいたします。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会ください。